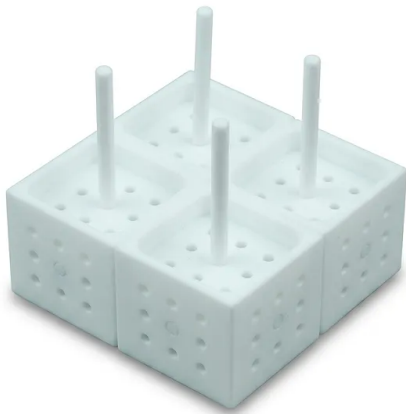


Cesta De Limpeza De Wafers Em Ptfе Personalizada, Resistente A Produtos Químicos, Suporte Em Fluoropolímero Para Gravação De Semicondutores E Processamento De Nova Energia

Número do item: PL-CP149



introdução

Otimize sua fabricação de semicondutores e nova energia com cestas de limpeza de wafers em PTFE personalizadas. Projetadas para resistência química extrema durante a gravação e limpeza RCA, esses suportes de fluoropolímero de alta pureza garantem a integridade do processo e durabilidade de longo prazo em ambientes industriais exigentes.

[Saiba mais](#)

| Aplicação | Descrição | Benefício Principal |
|---|---|---|
| Limpeza RCA de Semicondutores | Limpeza sequencial de wafers de silício usando soluções SC-1 e SC-2 para remover contaminantes orgânicos e metálicos. | Contaminação zero e resistência a misturas de amônia/peróxido. |
| Gravação com Ácido Fluorídrico (HF) | Remoção de óxidos nativos ou gravação controlada de camadas de dióxido de silício nas superfícies dos wafers. | Resistência absoluta ao HF, que dissolveria alternativas de vidro ou quartzo. |
| Texturização Fotovoltaica | Gravação química úmida de wafers de silício monocristalino ou policristalino para criar superfícies de aprisionamento de luz. | O alinhamento consistente das ranhuras garante texturização uniforme em grandes lotes. |
| Processamento com Solução Piranha | Remoção agressiva de resíduos orgânicos e fotoresist usando ácido sulfúrico e peróxido de hidrogênio. | Resiste a reações exotérmicas extremas e acidez de alta temperatura. |
| Enxágue Pós-CMP | Limpeza crítica de wafers após polimento químico-mecânico para remover polpas abrasivas. | Superfícies lisas e alta drenagem previnem a redeposição de partículas. |
| Preparação de Semicondutores Compostos | Limpeza especializada de wafers de GaAs ou InP para fabricação avançada de dispositivos eletrônicos e optoeletrônicos. | Geometria de ranhura personalizável para espessuras e tamanhos de wafer não padronizados. |
| Carregamento de Reator de Microcanais | Posicionamento de substratos dentro de câmaras de reação personalizadas para deposição controlada de vapor químico ou fase líquida. | Dimensões sob medida permitem encaixe perfeito em configurações laboratoriais personalizadas. |
| Desenvolvimento de Litografia | Segura substratos durante o desenvolvimento e remoção de camadas de fotoresist em fluxos de trabalho de microfabricação. | A resistência a solventes garante que o suporte não se degrade ou liberte gases durante o processo. |

| Parâmetro | Detalhe da Especificação para PL-CP149 |
|---|--|
| Identificador do Modelo | Série PL-CP149 |
| Construção do Material | PTFE (Politetrafluoretileno) 100% Virgem de Alta Pureza |
| Método de Fabricação | Usinagem CNC Totalmente Personalizada |
| Compatibilidade Química | Universal (Ácidos, Bases, Solventes, Oxidantes, HF) |
| Faixa de Temperatura Operacional | -200°C a +260°C (-328°F a +500°F) |
| Compatibilidade com Wafers | Personalizável para tamanhos de 2", 3", 4", 6", 8", 12" ou tamanhos não padronizados |

| Aplicação | Descrição | Benefício Principal |
|----------------------------------|--|---------------------|
| Parâmetro | Detalhe da Especificação para PL-CP149 | |
| Configuração das Ranhuras | Totalmente Personalizável (Passo, largura e profundidade variáveis) | |
| Número de Ranhuras | Definido conforme requisito do cliente (ex.: capacidade para 10, 25, 50) | |
| Design da Alça | Integrada, Destacável ou Estendida (Comprimento personalizável) | |
| Acabamento da Superfície | Acabamento usinado liso, de baixa porosidade | |
| Padrão de Pureza | Adequado para Análise de Traços e uso em Sala Limpa Classe 10/100 | |
| Recursos de Drenagem | Orifícios de drenagem inferior/lateral personalizáveis | |